

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和2年1月23日(2020.1.23)

【公開番号】特開2019-207923(P2019-207923A)

【公開日】令和1年12月5日(2019.12.5)

【年通号数】公開・登録公報2019-049

【出願番号】特願2018-101949(P2018-101949)

【国際特許分類】

H 01 L 21/304 (2006.01)

C 30 B 29/06 (2006.01)

C 30 B 33/00 (2006.01)

C 11 D 7/18 (2006.01)

C 11 D 7/54 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/304 6 4 8 G

C 30 B 29/06 B

C 30 B 33/00

C 11 D 7/18

C 11 D 7/54

【手続補正書】

【提出日】令和1年11月27日(2019.11.27)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

シリコンウェーハをSC1洗浄した後、酸化力を有する洗浄液で洗浄するシリコンウェーハの洗浄方法であって、

前記SC1洗浄により前記シリコンウェーハの表面に形成されたケミカル酸化膜を、前記酸化力を有する洗浄液で洗浄することにより、更に前記ケミカル酸化膜の厚さが1.0nm以上になるように成長させ、

前記SC1洗浄した後、前記酸化力を有する洗浄液で洗浄するより前に、SC2洗浄し

前記SC1洗浄するシリコンウェーハをDHF洗浄していないシリコンウェーハとすることを特徴とするシリコンウェーハの洗浄方法。

【請求項2】

前記酸化力を有する洗浄液として、オゾン水及び/又は過酸化水素水を用いることを特徴とする請求項1に記載のシリコンウェーハの洗浄方法。